



2SA1979S (3CG1979S)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

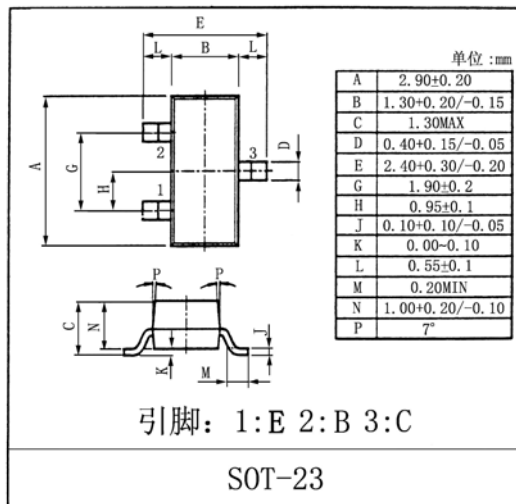
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点：集电极电流大, 饱和压降低, 与 2SC5342S (3DG5342S) 互补。

Features: Large I_C , low $V_{CE(sat)}$, complementary pair with the 2SC5342S (3DG5342S).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-40	V
V_{CE0}	-32	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-500	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-100\mu\text{A}$ $I_E=0$	-40			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-32			V
V_{EB0}	$I_E=-10\mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-40\text{V}$ $I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-1.0\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	70		240	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100\text{mA}$ $I_B=-10\text{mA}$			-0.25	V
f_T	$V_{CE}=-6.0\text{V}$ $I_C=-20\text{mA}$		200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-6.0\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		7.5		pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications	0	Y
h_{FE} 范围/ h_{FE} Range	70~140	120~240
印章/Marking	HAA0	HAAY

